

デバイス・材料

- **115** デバイス製造・検査
- 119 半導体
- 120 ディスプレイ
- 121 材料ほか

ライフサイエンス分野の研究に新たな道を開く, ナノプリント技術を応用した細胞培養シート



日立研究所材料研究所電子材料研究部ナノプリントストラテジック ソリューションユニットリーダの宮内昭浩主任研究員(左)と、トータル ソリューション事業部プロジェクト統括本部ナノプリントソリューション センタの根本雅文主任技師右)

樹脂薄膜の表面へ微細なパターンを転写するナノプリント技術は, エレクトロニクスやライフサイエンスなどのさまざまな産業分野でプレイク スルーを起こす可能性を持った技術として期待されている。日立製作所は,独自のナノプリント技術を開発するとともに,装置の提供などを通じ, ナノプリント技術の発展に力を注いでいる。2005年には,パイオや医療, 製薬分野の新たな研究支援ツールとして,この技術を応用した細胞培養シートを製品化した。

ナノプリント技術とは

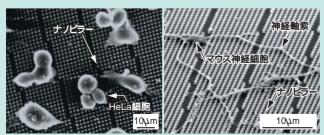
基本原理をわかりやすく言うと、ナノスケールでのプレス成形技術です。まず、ニッケルやシリコンに微細な凹凸を彫り込んだナノ金型を作ります。そして、ガラスやシリコン、プラスチックなどの基板の上に薄く塗布した樹脂へその金型を押し当て、凹凸のパターンを転写するというものです。

半導体製造分野を中心に発展してきた微細加工技術では, 現在,光リソグラフィーが主流となっており,LSIの最小線幅が65 nmというレベルまで達しています。インフルエンザウイルスの大きさが100 nm程度ですから,いかに微細加工かわかりますね。そうしたナノスケールでの加工で,さらに低コスト・高スループット化を可能にする技術がナノプリントです。これが実用,量産化の段階に至ると,バイオチップ,ストレージメディア,LSIなどの分野に技術革新をもたらすと期待されています。

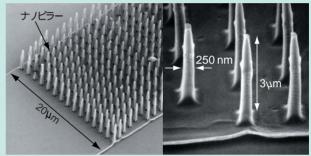
なぜ細胞培養シートへの応用を

ナノプリントの実験で金型の凹部に樹脂を充てんし,金型を 樹脂膜からはく離して形状を転写していたところ,はく離する際 に樹脂を引き伸ばすことで,金型の凹部の深さよりも長い柱を 形成できることがわかりました。これを「高アスペクト比ナノプリント 技術」と名付けました。

そのような構造体は、従来の精密プラスチック成型技術では実現できなかったものです。このユニークな素材を活用する方法を探っていたところ、バイオメディカル分野で細胞培養時に細胞が固着する足場の構造が培養特性に影響を与えるかもしれない情



細胞培養シートの適用例



高アスペクト比ナノプリント技術で形成したナノピラー構造(アスペクト比12)

報を知りました。そこで、ナノプリントで形成した微細な柱状構造を細胞培養シートに使えないかというアイデアが生まれたのです。

シャーレなどのフラットな面で行う一般的な細胞培養に対し, 高さ200 nm ~ 1 \(\text{\mu} \) , 径240 nm ~ 2 \(\text{\mu} \) の柱が並んだナノ ピラーのような構造では,細胞と足場との接触面積が非常に 小さくなります。そのため,細胞のはく離性が高く,タンパク質 分解酵素を使わずに細胞が取り出せるので,細胞活性が低下 しないという利点があります。さらに,これまでは見られなかった ような成長形態も観察されています。

また,ナノピラーの太さや間隔を変えると細胞の成長状況も変化することが明らかになっており,北海道大学,産業技術総合研究所との共同研究の成果や,実際に製品を提供しているお客様の声を反映しながら,本格的な普及に向けて,細胞の培養特性と足場形状との相関関係を確立しつつあります。

ナノプリントの展望は

技術としてはまだ黎(れい)明期にあるナノプリントですが, 日立グループは, 樹脂材料・ナノ金型・プレス装置などの必要な技術をすべてそろえ,総合的にアプローチできる企業グループとして,ナノプリント分野そのもののすそ野を広げたいと考えています。そのためにも,まずは,最初の製品展開となるこの細胞培養シートを成功事例にできるよう,再生医療や製薬,バイオなどの発展に寄与できる研究支援ツールに育てていくことが目標です。

の超高温処理による 世界初,1,350 SOI ウェーハの量産用 300 mm 縦型 バッチ式 超高温アニール装置





株式会社日立国際電気電子機械事 業部量産プロセス開発部の中嶋 定夫部長(左) と同部の中村厳(右)

絶縁層の上に単結晶シリコン層を形成したSOIウェーハは,LSIの微 細化に非常に有効な技術であり、数年後にはLSI製造技術の主流にな るものと予想されている。LSIの低消費電力化、高性能化に最適とされ るSOIウェーハの中でも、製造工程が少なく低コストのSIMOXウェーハ が注目されており、株式会社日立国際電気は、その量産化に対応した 超高温アニール装置の開発に成功した。

超高温アニール装置とは

酸素イオンを注入したシリコンウェーハを 1,350 という超高温でアニール(焼なまし)と 酸化処理することにより、シリコンウェーハ中に 酸化シリコンの絶縁層を形成してSOI(Silicon on Insulator)ウェーハを作る装置です。埋め込 まれた酸化シリコン層の厚みは100~150 nm. その上に50~100 nm厚の単結晶シリコン層を 形成することで、均一できわめて薄いSOI膜厚を 実現できます。また、シリコンはおよそ1,420 で 融けてしまうため、1.350 までのぎりぎりの温度 を±0.5 という高精度でコントロールしていま

す。これらの精密制御により,高品質なSIMOX(Separation by Implanted Oxygen ウェーハの量産が可能になりました。

なお,この技術は,独立行政法人新エネルギー・産業技術 総合開発機構(NEDO)の先端的デバイスプロセス装置技術 開発の一環として助成を受け、3年の研究を経て開発に成功 したものです。

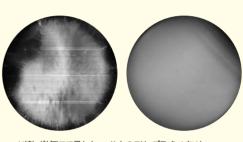
超高温アニール装置の特徴は

1,000 以上の高温で処理する場合,シリコンウェーハの表 面に「スリップライン」と呼ばれる微細な亀裂が生じることがあり ます。規則正しく並んでいるシリコン原子が高温のためにずれる ことで起こる「結晶欠陥」現象です。このスリップラインはLSI デバイスの特性を劣化させるため、デバイスメーカーにとって最大 の課題となっていました。そのため、さまざまな実験、データ解析 を繰り返し、まったく新しいウェーハの支持法を工夫することで この課題を解決しました。高温処理による量産ベースでは世界 で初めて、結晶欠陥フリーを実現しています。

シリコンの高温処理にはもう一つ,金属汚染という大きな 問題があります。高温であればあるほど,装置の素材などの 金属原子(Feなど)が飛来してシリコンウェーハ内に入り込み, シリコンを汚染するのです。この金属汚染も,最終製品である



超高温アニール装置



X線トポグラフで見たウェーハ上のスリップライン(左)と ウェーハ支持法の改良によってスリップの発生を抑えた例(右)

デバイスの特性を劣化させます。そこで,装置内にウェーハを 囲むように特別な反応管を置くことで金属汚染を低減させる ことに成功しました。さらに ,超高温下でのクリーニング用ガス による反応炉内クリーニングという初の試みで金属汚染をクリア しています。

今後のビジネス展開は

この300 mm 縦型バッチ式超高温アニール装置は,超高温 処理を実現した装置であるとともに、最先端のLSI製造に用い られる300 mm 径ウェーハという最大サイズに対応していること も大きな特徴です。また、1バッチ75枚のウェーハを処理できる という最高水準の処理能力を持っています。そのため、SIMOX という技術の広がりに伴い、その熱処理装置としての需要も 大きく伸びるものと予想され,今後も,スリップラインの発生を 限りなくゼロに近づけるなど次のステップへの改良を続け、高度 化するユーザーの要求に応えていきたいと考えております。

また,この装置で培った超高温処理,スリップライン対策, 金属汚染対策といった高度な技術は、それほど超高温を必要 としない従来の分野にも当然展開できるため,広く周辺分野に 活用していくことで新たなビジネスが生まれるものと期待されて います。

デバイス製造・検査

IT・エレクロトニクス産業のキーデバイスである半導体・フラット パネル ディスプレイの高集積化と生産 性向上へのニーズに応えるため,日立グループは,最先端の技術を駆使した製造・検査装置のほか,生産 歩留り向上を支援する各種検査・評価システムを提供している。



新絶縁膜エッチング装置" U-8250 "

45 nm ノード絶縁膜加工用にエッチング装置" U-8250 "を 開発した。

U-8250は,実績あるECR(Electron Cyclotron Resonance)プラズマエッチング技術を継承し,微細加工性と 安定した稼動を提供する。

〔主な特徴〕

- (1)多種絶縁膜材料に対応 プラズマ,ウェーハ入射イオンなど制御機能を拡充
- (2) COO(Cost of Ownership)改善 パーティクルレスと低コンタミネーションを追求したリアクタ
- (株式会社日立ハイテクノロジーズ)
- (発売時期:2005年12月)



新絶縁膜エッチング装置" U-8250



45 nm ノードに対応した 高解像度・高速の暗視野ウェーハ欠陥検査装置 IS3000 "



高解像度・高速の暗視野ウェーハ欠陥検査装置" IS3000 "

300 mm 径ウェーハの量産現場では,製造装置やプロセス などからさまざまな微小欠陥が発生し歩留りを低下させており、 また、その発生原因もさまざまである。このため、できるだけ多 くの個所の欠陥モニタリングを感度よく行い,不良原因をすば やく突き止め,迅速に対策をとることが求められている。

このようなニーズに応えるため,暗視野イメージング技術を応用 し,45 nm ノード微細化デバイスの量産に対応した高解像度・ 高速検査が可能な暗視野ウェーハ欠陥検査装置を開発した。

- (1) 高解像度暗視野イメージング光学系により,高解像度検 査と高速検査を両立
- (2) 最大毎時35枚のスループットを実現(300 mmウェーハ)
- (3) 短時間で設定可能なレシピ作成機能
- (4)検出欠陥の解析機能を搭載
- (株式会社日立ハイテクノロジーズ)
- (発売時期:2005年9月)



設計データを活用した半導体パターン計測技術 DesignGauge "

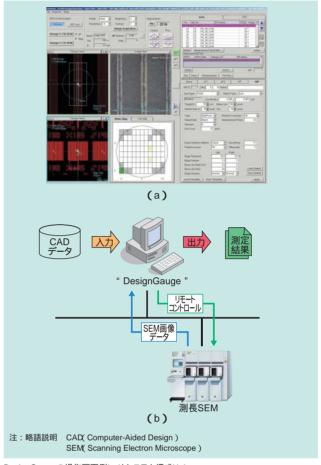
半導体プロセスのいっそうの微細化に伴い、CADデータ どおりのパターン形成が困難になってきている。そのため、CADデータとパターンの照合比較評価を行う設計データ応用計測システム" DesignGauge を開発した。DesignGaugeは PC上で動作し、測長SEMとネットワーク経由で接続する。 [主な特徴]

- (1) オフラインレシピ作成機能
- (2) リモートコントロール機能
- (3) CADデータを活用した測長機能
- (4)再測長機能

今後は、CADデータとパターンとの照合技術を発展させ、CADデータを用いた二次元計測技術を確立し、測長SEMの付加価値を高めていく。

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売予定時期:2006年2月)



DesignGaugeの操作画面例 a とシステム構成 b)



次世代デバイス対応高感度・高速 SEM 式外観検査装置 1-6300 "



高感度·高速SEM式外観検査装置"I-6300"

45 nm ノード以降の次世代デバイス生産対応検査装置として 高感度・高速の新形 SEM(走査電子顕微鏡)式外観検査 装置"I-6300 を開発した。

デバイスの微細化と多層化に伴い,高感度検査や電位コントラスト検査が可能なSEM式検査装置では,高スループット化が課題であった。I-6300では,新電子光学系と新高速画像処理の搭載によって従来装置比で3倍以上の高スループットを実現し,あわせて検出感度と再現性の向上を図った。

〔主な特徴〕

- (1)新電子光学系と高速画像処理により,高速・高感度検査が可能
- (2)新形電極による電位コントラスト検出感度と再現性の向上
- (3) レシピ作成支援ツールの高度化により、使いやすさの向上とレシピセットアップ時間の短縮

(株式会社日立ハイテクノロジーズ)

(発売時期:2005年10月)



縦型超高温アニール装置

300 mm 縦型バッチ式超高温アニール装置を開発した。 この製品は,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構(NEDO)の先端的デバイスプロセス装置技術開発の一 環として,平成14年度から3年間にわたって取り組んできたも ので, SIMOX(Separation by Implanted Oxygen)ウェー ハのアニールプロセスに必要な1,350 以上の加熱技術,温 度制御技術,結晶欠陥低減技術,金属汚染低減技術などの 高度化技術を結集した装置である。

[主な特徴]

(1) 高スループット

縦型バッチ式装置の自動搬送機構を装備し,最大1バッチ 75枚処理を実現

(2)精密温度制御

SIMOXアニールに必要な1,350 を上回る,最高処理温 度1,400 までを±1 の高精度で制御

(3) 高精度プロセス

- (a)結晶欠陥フリー:バッチ処理でのスリップラインフリーを実現
- (b) 金属汚染低減:金属汚染量5×10¹⁰ atms/cm²以下を達成

(c)バッチ間酸化膜厚均一性:0.2%以下を達成

(株式会社日立国際電気)

(発売時期:2005年12月)



縦型超高温アニール装置



300 mm **径ウェーハ対応チップマウンタ** CM-700R "



↓BGA対応チップマウンダ CM-700R "の対象製品と概要

メモリデバイス(DRAM: Dynamic Random Access Memory)で高速動作が可能なRDRAM(Rambus DRAM) とDDR (Double Data Rate)用のu BGA*パッケージ組立を 対象とした,300 mm 径ウェーハ対応チップマウンダ CM-700R " を開発した。

この装置では ,LOC(Lead on Chip)/BOCに対応した "CM-700 をベースにリールツーリール搬送方式を採用し,高 スループットと高組立精度を実現した。

[主な特徴]

- (1) 高生産性:1,500 IC/h(従来比150%)
- (2) CM-700の信頼性に高精度組立機能をプラス
- (3) \uBGA 対応 ,オプションで狭パッドピッチにも対応可 〔主な仕様〕
- (1) インデックスタイム:3 s/IC
- (2)組立(マウント)精度: ±15 μm/(3)

±5 µm/(3 (高精度・オプション)

- (3) パッドピッチ: 100 µm(狭ピッチ: 65 µm)
- (4) 装置寸法:幅3,300×奥行き1,420×高さ1,800(mm)
- (株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ)
- (発売時期:2005年4月)
- * は 他社登録商標など (163ページ)を参照



大型テレビ対応モジュール組立設備「AL/AB6000シリーズ」

大型テレビ 最大47型ワイドパネル)に対応し, TAB(Tape Automated Bonding)搭載からPCB(Printed Circuit Board)接続, 樹脂塗布までの全自動一貫ライン化を実現したモジュール組立設備を開発した。



大型テレビ対応モジュール組立設備「AL/AB6000シリーズ」

〔主な特徴〕

(1)高い生産性

現在主流の32型ワイドパネルの2辺に14TAB搭載で25秒 の高速ラインタクトを実現

- (2) 生産のフレキシビリティを確保
 - (a)生産ラインのプロセス,タクトタイムに合わせて各種ユニットやバッファを自由に組み合わせることが可能
 - (b) 27から47型ワイドまでの幅広いパネルサイズに対応が 可能

(3)高稼動率

TABテープやACF(Anisotropic Conductive Film)テープなどの部材自動交換機能により,長時間連続運転が可能(日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社)



液晶用フォトスペーサ高さ測定装置「GH7000シリーズ」

液晶の表示品質向上には、カラーフィルタ上にフォトリングラフィー法で加工した柱状の突起(フォトスペーサ)の高さ精度管理が重要である。このフォトスペーサを高速・高精度で測定できる高さ測定装置「GH7000シリーズ」を開発した。

〔主な特徴〕

(1)非接触高精度測定

白色光共焦点光学系とCCD(Charge Coupled Device) カメラ画像により、カラーフィルタ面とフォトスペーサの輝度情報から非接触でフォトスペーサの高さを測定

(2)高い測定再現性

独自の画像処理技術(ピーク処理, ノイズカット処理)によって高い測定再現性を実現

(3)フォトスペーサの高さと位置を同時測定

カメラ画像情報からフォトスペーサの位置ずれも同時測定できるほか,解析モードでは三次元プロファイル表示で形状分析が可能

(日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社)

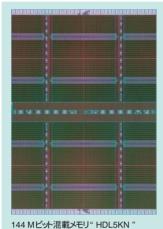


フォトスペーサ高さ測定装置「GH7000シリーズ」

ユビキタス情報社会の地球規模的発展に伴い、音声や画像などの大量なデータがネットワーク上で流れている。このため、データを高速で確実に処理できる情報・通信装置が求められている。これを実現するために、通信・ネットワーク向けメモリLSIと高性能CMOS ASICシリーズを開発した。



ギガビットからテラビット級の通信・ネットワーク装置向け 144Mビット/s 高速混載メモリLSI



アクセス時間: 10 ns 動作周波数: 500 MHz データバンド幅: 8 G バイト/s



高速混載メモリ" HDL5KN 'のゲッケージ 高速混載メモリ" HDL5KN 'のチップと主な仕様 153ピンFC-BGA

ユビキタス情報社会の発展に伴い、PCや携帯電話などのおびただしい数のノードを結ぶネットワーク上には、音声・画像データを含む大量のデータが流通している。このため、ルータ・スイッチに代表される通信・ネットワーク装置の高速化と、低価格化は、ユビキタス情報社会のいっそうの進化・発展に不可欠となっている。

データ送受信の単位であるパケットの一時記憶であるパケットバッファや、パケットの行き先アドレスを記憶するアドレステーブルなどの記憶素子としては、従来SRAM(Static Random Access Memory)が広く使用されてきた。HDL5KNは内部に高速DRAM(Dynamic Random Access Memory)を混載し、SRAMの4倍の集積度と8Gバイト/sの高データバンド幅(SRAMは4.8Gバイト/s)を実現した、世界最高性能のネットワーク向けメモリLSIである。通信・ネットワーク装置の高性能化と低価格化に寄与するために、今後、幅広く展開を図っていく。

ディスプレイ

高度情報化社会のキーデバイスであるディスプレイの応用分野は ,大型液晶テレビや携帯電話 ,デジタルカメラ ,アミューズメントなどに拡大している。日立グループは ,高画質IPS技術や高精細低温ポリシリコン技術など独自技術を使い ,32型ハイビジョンテレビ用 TFT ,3.1型デジタルカメラ用 16:9 画面アスペクト TFT など ,各分野のニーズに対応した液晶ディスプレイを開発し ,提供している。



動画性能を向上させた テレビ用80 cm(32型16:9)TFT液晶モジュール

液晶テレビでは ,ハイビジョン放送に対応した16:9の画面 アスペクト比と ,動画性能向上が求められている。

今回,液晶テレビ用として,IPS-Pro(In-Plane Switching Provectus)方式TFT(Thin-Film Transistor)液晶モジュールにバックライトブリンクとスーパーインパルス表示技術(黒挿入駆動を加え,動画性能を向上させた液晶モジュールを開発した。 [主な仕様]

- (1) 画素数:(水平)1,366×(垂直)768
- (2)輝度:520 cd/m²
- (3) コントラスト:880対1(正面)
- (4)色再現性:72%(NTSC比)
- (5)外形寸法:幅760×高さ450×奥行き50.5(mm)
- (株式会社日立ディスプレイズ)
- (発売時期:2005年7月)



動画性能を向上させたテレビ用80 cm(32型16:9)TFT液晶モジュール



デジタルカメラ用

16:9アスペクトIPS低温ポリシリコンTFT液晶ディスプレイ



7.9 cm(3.1型)16:9アスペクトIPS低温ポリシリコン TFT 液晶ディスプレイ

ハイビジョンテレビには、人間の視野にマッチした16:9という 画面アスペクトが一般的に使われており、デジタルカメラでも、16:9アスペクトディスプレイの要求が高まってきている。この ため、対角7.9 cm(3.1型)16:9アスペクトの高精細低温ポリシリコンTFT(Thin-Film Transistor)液晶ディスプレイを開発した。全方位で高い色再現性が得られるIPS(In-Plane Switching)表示モードや、屋外での視認性確保のための微反射性を特徴としている。

〔主な仕様〕

- (1)表示ドット数:(水平)960×(垂直)240
- (2)表示サイズ: 7.9 cm(3.1型)
- (3) 視野角:上下左右 170 以上
- (4)色再現性:50%(NTSC比)
- (5) RGB 8ビット デジタル インタフェース
- (株式会社日立ディスプレイズ)

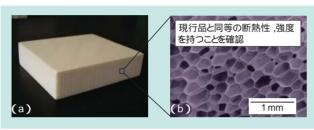
(発売予定時期:2006年4月)

材料ほか

物質の特性や機能を大幅に向上させ、さまざまな分野にパラダイム転換をもたらし、社会や産業を変革させる技術として、ナノテクノロジーが注目されている。日立グループは、産学官連携を図るとともに、グループ各社の技術を集結し、「IT・エレクトロニクス」、「エネルギー・環境」、「医療・バイオテクノロジー」、「新材料・基盤技術」の研究開発を推進し、豊かな社会の構築に貢献することを目指している。



冷蔵庫ウレタン断熱材のケミカルリサイクル技術



ケミカルリサイクルウレタンの外観(a)と断面の走査電子顕微鏡写真(b)

環境保護と低コスト化の観点から,廃ウレダンのリサイクルが注目されている。冷蔵庫のウレダン断熱材のリサイクル法として,熱硬化性樹脂でリサイクルが難しいウレダン樹脂に対して有効なグリコール分解によって廃ウレダンを原料に戻すケミカルリサイクル技術を開発した。今後は,事業化に向けた課題である分解反応のスケールアップを検討するとともに,冷蔵庫に用いた場合の性能を検証する。

(日立ホーム&ライフソリューション株式会社)

(発表時期:2005年5月)

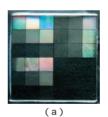


ナノプリントによる細胞培養シートの開発

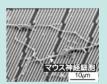
日立グループのナノプリント技術に半導体微細加工技術を組み合わせることで,ナノピラーと呼ばれる極微細な突起構造を 高密度に集積した細胞培養シートを世界で初めて実現した。

細胞をナノピラー上で培養させると、従来の平滑な樹脂表面での細胞培養に比べて細胞とシート材との接触面積が低減するため、培養細胞を容易に回収できるという利点がある。さらに、細胞種によっては特異な成長形態を取りえることがわかり、新しい研究用ツールとしての活用が期待されている。

(発売時期:2005年6月)







HeLa(ヒト子宮頸癌(けい) マウス大脳皮質神経細胞がん)由来癌細胞) (北海道大学との共同研究) (独立行政法人産業技術総合研究所との共同研究)

(b)

細胞培養シート(a)と培養細胞の観察例(b)



インバータサージを考慮した絶縁評価・解析技術の開発

電力・電機機器の絶縁では,エネルギー高効率利用に活用されているインバータのサージ(急峻(しゅん)パルス)電圧が重

実際の電圧波形(例) 開発技術 従来技術 インバータ 絶縁寿命評価 インバータ模擬電圧 正弦波電圧を使用 を使用 サージに対する 絶縁劣化信号の 計測・解析 可能 不可 サージに対する機器絶縁設計 測定結果に基づく 正弦波劣化特性 電力電機機器(対象)

インバータの駆動機器構成例 左 と ,新技術と従来技術の比較 右)

要になりつつある。しかし、サージ電圧を考慮した絶縁設計は、これまで困難であった。このため、インバータ模擬電源とサージ

対応劣化信号処理により、インバータに対する絶縁寿命評価と劣化信号の計測・解析を可能とし、サージ電圧を正確に考慮した絶縁設計を確立した。今後、この技術を、普及が期待される電気自動車用機器にも適用していく。

(発表時期:2005年3月)

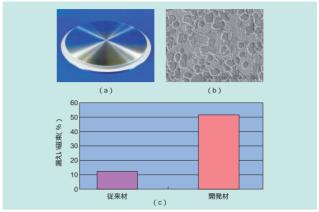


垂直磁気記録メディア用ターゲット材

垂直磁気記録方式のハード ディスク メディア用ターゲット材には ,高い使用効率と均質性が求められる。このニーズに応え ,軟磁性裏打ち層に用いられる高品質なCo-Zr 系合金と , Fe-Co-B 合金ターゲット材を開発した。このターゲット材では強い漏えい磁束が得られるため ,使用効率が高く ,均質な組織を備えており ,ライフエンドまで安定して高品質な薄膜を形成できる。このターゲット材により ,ユーザーの生産性向上に貢献することが期待できる。

(日立金属株式会社)

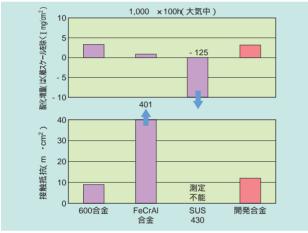
(発売時期:2005年4月)



Co-Zr-Ta合金ターゲット材(a)のミクロ組織(b)とASTM F1761法による漏えい磁束測定結果の比較例(c)



SOFC**用セパレータ材**



SOFCの金属セパレータ用開発材の耐酸化性と導電性の位置づけ

SOFC(Solid Oxide Fuel Cells:固体電解質型燃料電池)は,高温作動(約600~1,000)の高効率燃料電池である。今回,SOFCの金属セパレータ用に開発したFe-22%Cr系合金は,(1)作動温度での良好な導電性(低接触抵抗),(2)作動温度での長時間にわたる良好な耐酸化性,(3)電解質YSZ(ジルコニア系セラミックス)に近い低熱膨張係数(約13×10-6/)など,従来の合金にない特性バランスを持つ。今後,SOFCの実用化への貢献が期待できる。

(日立金属株式会社)



PAX システム用アルミホイール

パンクしても一定距離の走行が可能な、ミシュラン社開発の PAXシステム(中子式ランフラットタイヤ)用のアルミホイールを 開発し、量産を開始した。

ホイールリム部は中子装着を考慮した特殊形状であり、パンク 状態では、ホイールリム中間部への走行入力に耐える必要が ある。そのため、これまでにないリム設計技術が必要とされて いた。この製品を製造するために、強度解析技術と製造技術 を新規に構築した。

(日立金属株式会社)



PAXシステム(中子式ランフラットタイヤ)用アルミホイール(写真提供:日本ミシュランタイヤ株式会社)



極薄プリント配線板用材料「Cuteシリーズ」

極薄のプリント配線板用材料「Cuteシリーズ」 を開発した。多層材料としては世界に先駆け て,同一樹脂系で極薄ガラス布入り材料と接 着フィルムをラインアップした。多層配線板の いっそうの薄型化に対応するだけでなく,モバ イル端末電子機器などの狭小スペースへの三 次元実装にも適用できる,折曲げ可能な多層

ビア形成可能 TC-F TC-C TC-F 実装領域(ビルドアップ層) (同一樹脂系で高信頼性確保) 折曲げ領域 C/Lとビルドアップ層を同時形成 高信頼性 折曲げ性 Cuteの折曲げ例 プロセス性 Cuteの構造例(オールCute4層ビルドアップ構造) (TC-C;Cute両面板,TC-F;Cuteビルドアップ材) 注:略語説明 C/L(カバーレイ)

配線板をリジッド基板と同様のプロセスで可能にした。「Cuteシ リーズ」ではハロゲンフリー材や高耐熱性材の開発も進めており、

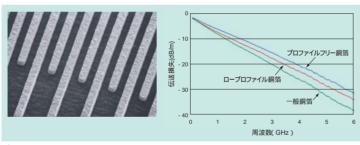
今後ますます多様化する極薄配線板のニーズに対応していく。 (日立化成工業株式会社)



微細配線,高周波対応プロファイルフリー銅箔

近年の電子機器のプリント配線板では、いっそう高密度な回

路形成と高速伝送対応が求められている。そのため ,サブトラ



プロファイルフリー銅箔を使用した微細配線形成性の例(ライン アンド スペース=15:15 km) 左 と伝 送損失低減効果の例(右)(基材:日立化成工業株式会社のLX-67Y)

クティブ法による高密度配線と低伝送損失対応が可能なプロ ファイルフリー銅箔(はく)を開発した。

> この製品では,非常に平滑な表面を持たせながら, 基材と接着する側に新規に開発した特殊処理を行う ことでロープロファイル箔と同等のピール強度を確保し ているほか,容易な微細配線形成と信号の伝送損失 低減を可能とした。今後,これらの特長を生かした高 性能,高機能分野への展開が期待できる。

(日立化成工業株式会社)

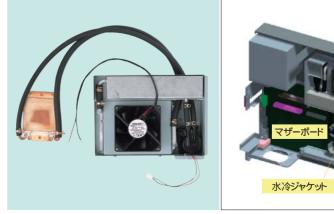
(発売時期:2006年1月)



サーマル コンポーネント ソリューション

高発熱のCPU(Central Processing Unit) を搭載するPC,サーバ,ワークステーションな どを安定かつ静音で冷却したいというニーズ に応え,発熱量100 W クラスの CPUを搭載す るスリムPC対応の水冷モジュール(騒音: 30 dB(A)以下)と,発熱量140 Wクラスの CPUに対応が可能な一体形(水冷ジャケット, ポンプ ,ラジエータ ,タンクー体)小型・高性能 水冷モジュール 騒音37 dB(A)以下 を開発 した。

これらの水冷モジュールは高信頼で,かつ5 年間メンテナンスフリーを実現している。



スリム PC 対応の水冷モジュール